

3端子MOS構造

群馬大学
松田順一

概要

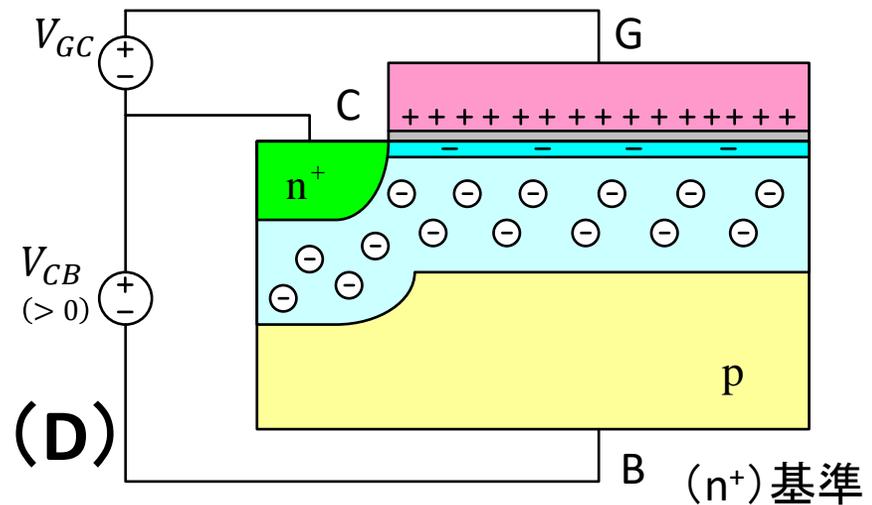
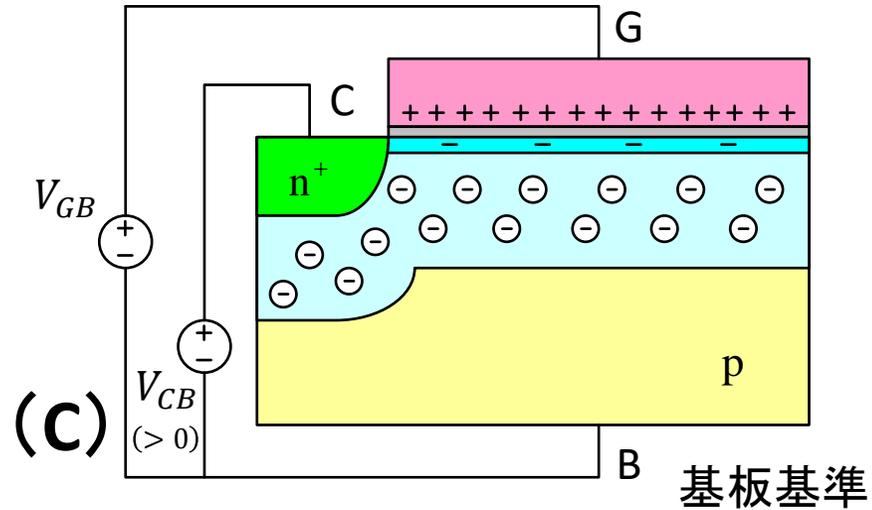
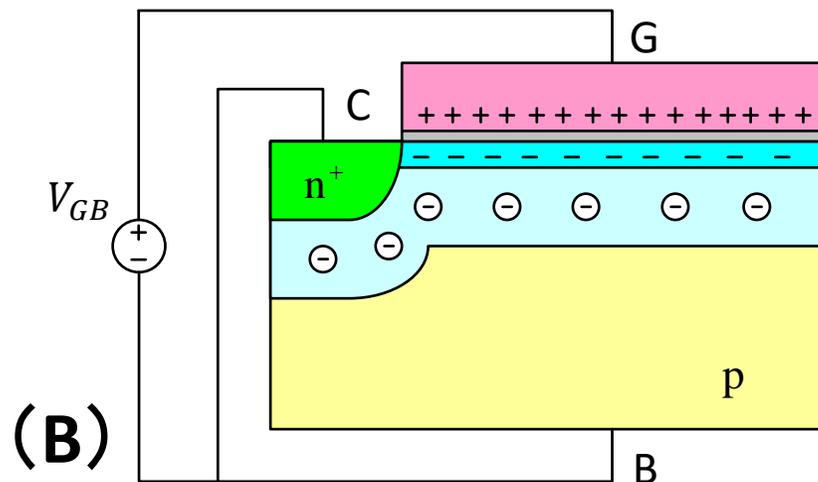
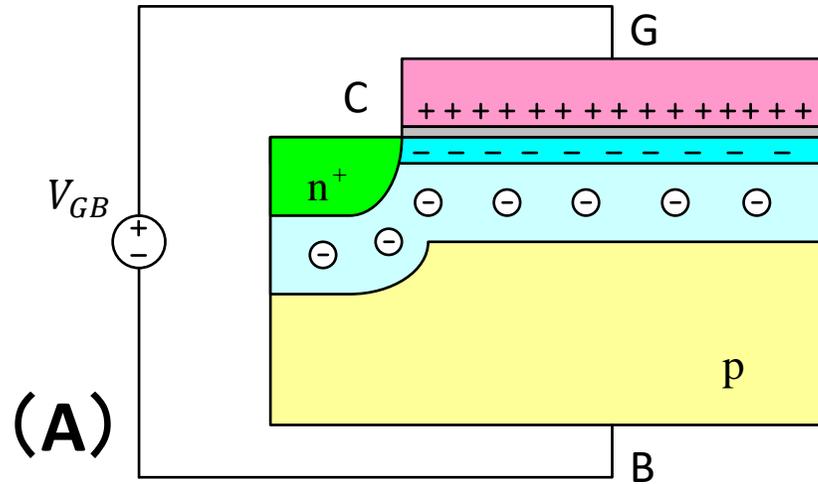
- 反転層へのコンタクト
- 基板効果
- 反転領域
 - 強反転
 - 弱反転
- 基板電圧制御
 - ピンチオフ電圧

(注)以下の本を参考に、本資料を作成。

(1) Yannis Tsividis, Operation and Modeling of the MOS Transistor Second Edition, McGraw-Hill, New York, 1999.

(2) Yannis Tsividis and Colin McAndrew, Operation and Modeling of the MOS Transistor Third Edition, Oxford University Press, New York, 2011.

3端子MOS構造



ゲート電荷 Q_G
 = 反転層電荷 Q_i + 空乏層電荷 Q_B
 (界面電荷をゼロとした場合)

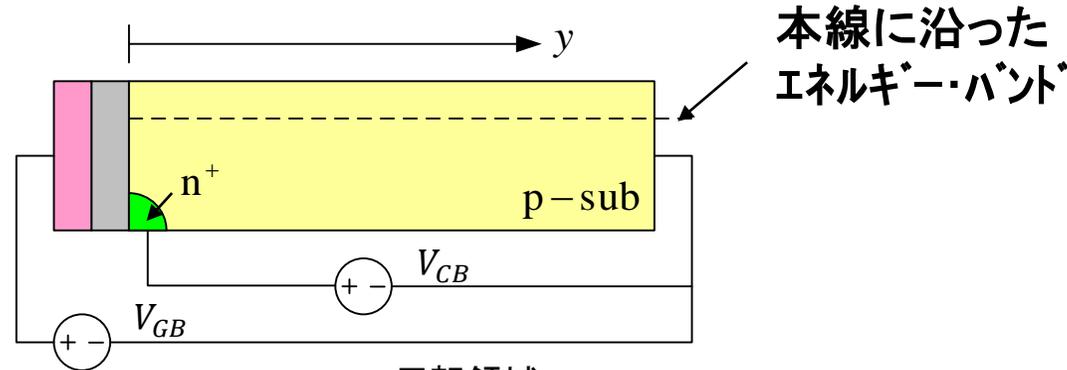
$V_{CB} = 0 \Rightarrow V_{CB} > 0, V_{GB}$ (変化なし)

- ・ Q_G 変化なし
- ・ Q_B 増大 (空乏層幅増大)
- ・ Q_i 低下

$$V_{GB} = V_{GC} + V_{CB}$$

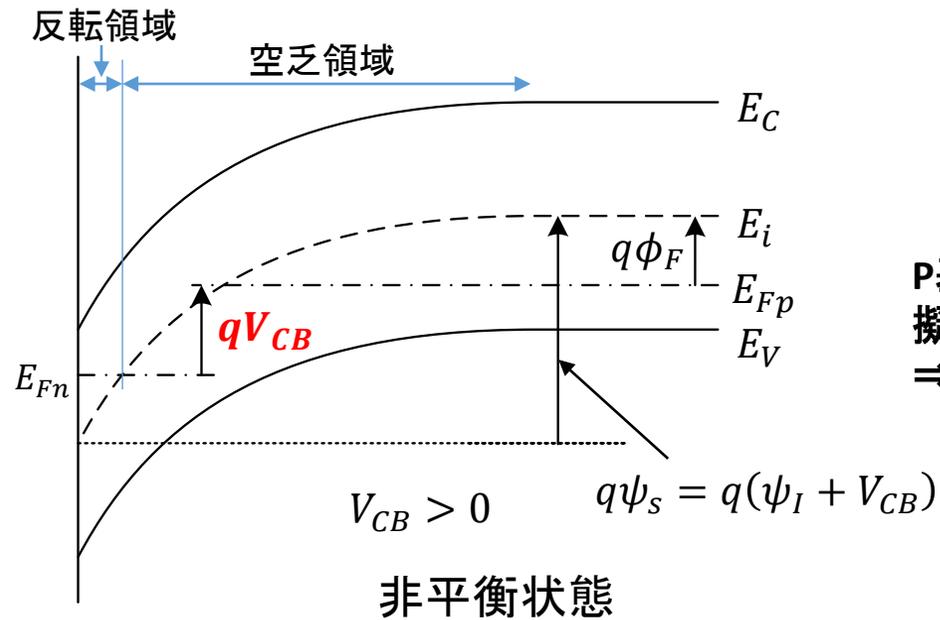
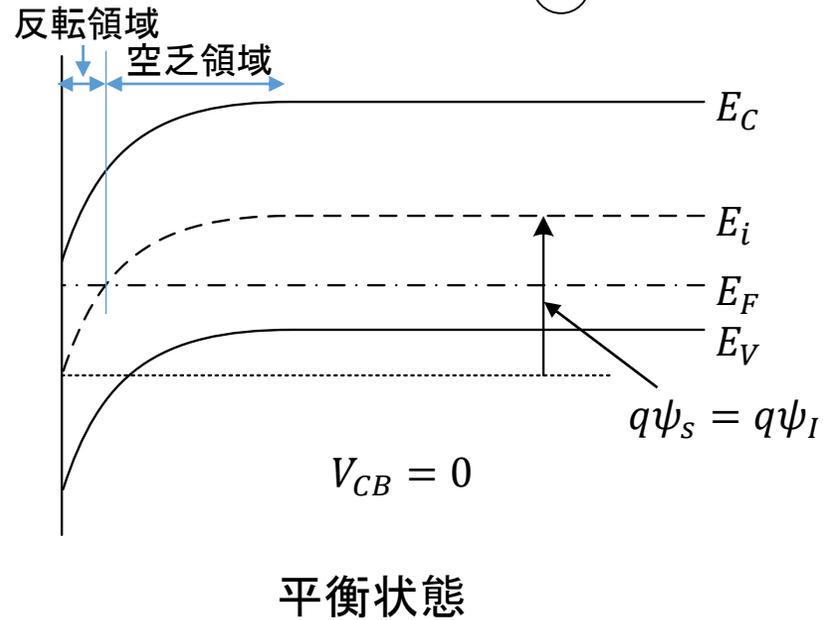
$$\Rightarrow (C) = (D)$$

3端子MOS構造におけるエネルギー・バンド図(1)



電子密度 n

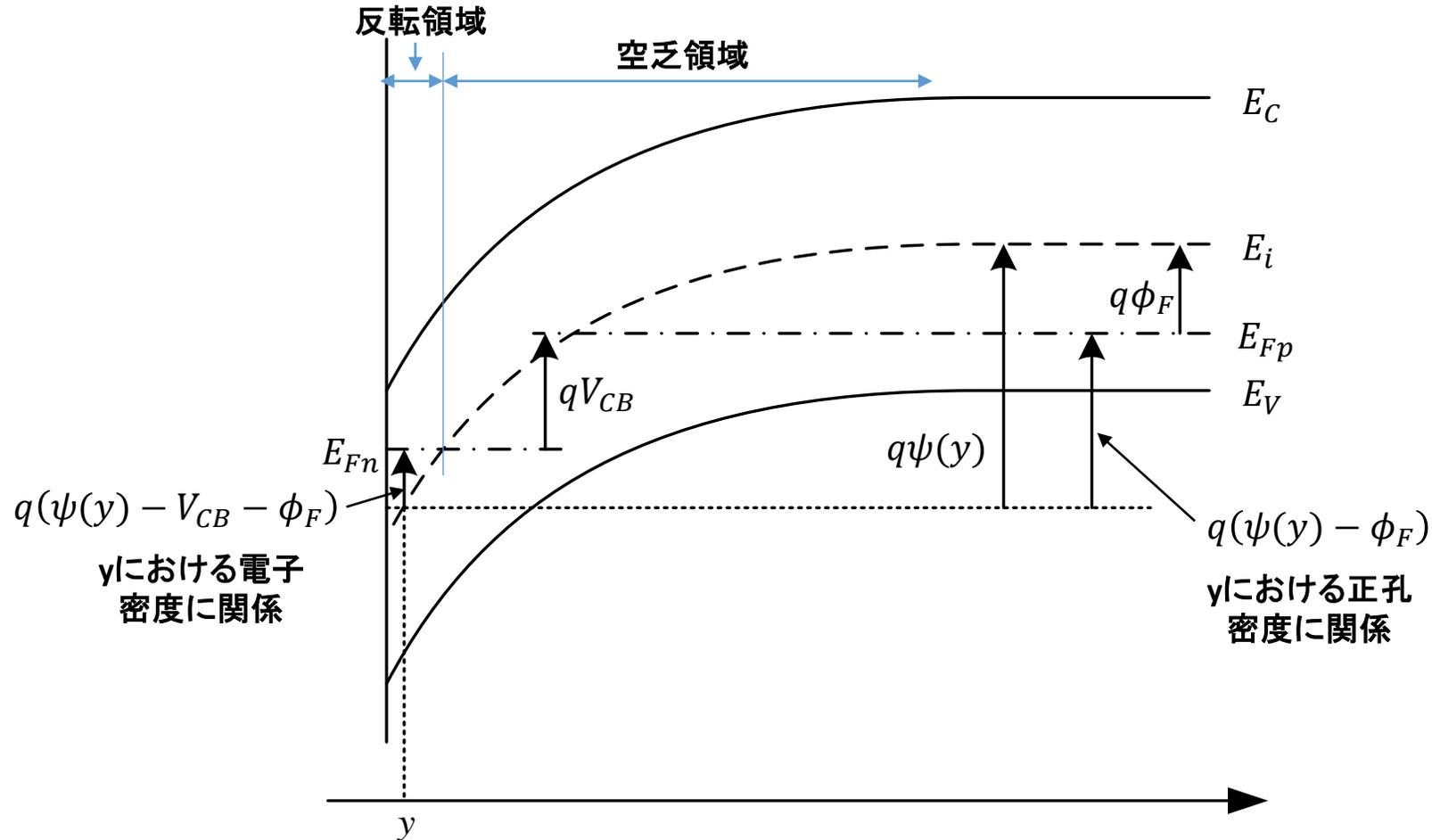
$$n = n_i \exp\left(\frac{E_{Fn} - E_i(y)}{kT}\right)$$



P基板と界面の
擬フェルミレベルの差
⇒ n⁺/p基板間の電位差
(強反転の場合)

反転状態にある場合

3端子MOS構造におけるエネルギー・バンド図(2)



電子密度 n

$$n = n_i \exp\left(\frac{E_{Fn} - E_i(y)}{kT}\right)$$

正孔密度 p

$$p = n_i \exp\left(\frac{E_i(y) - E_{Fp}}{kT}\right)$$

3端子MOS構造(電子密度)

深さ y 方向の電子密度 $n(y)$ は以下になる。

$$\begin{aligned}n(y) &= n_i \exp\left(\frac{E_{Fn} - E_i(y)}{kT}\right) = n_i \exp\left(\frac{\psi(y) - V_{CB} - \phi_F}{\phi_t}\right) = n_0 \exp\left(\frac{\psi(y) - V_{CB}}{\phi_t}\right) \\ &= p_0 \exp\left(\frac{\psi(y) - 2\phi_F - V_{CB}}{\phi_t}\right) \cong N_A \exp\left(\frac{\psi(y) - 2\phi_F - V_{CB}}{\phi_t}\right)\end{aligned}$$

$$\because \phi_F = \phi_t \ln\left(\frac{n_i}{n_0}\right) \Rightarrow n_i = n_0 \exp\left(\frac{\phi_F}{\phi_t}\right), \quad \phi_F = \phi_t \ln\left(\frac{p_0}{n_i}\right) \Rightarrow n_i = p_0 \exp\left(-\frac{\phi_F}{\phi_t}\right)$$

したがって、表面電子密度 $n_{surface} = n(0)$ は、 $\psi(0) = \psi_s$ として

$$n_{surface} \cong N_A \exp\left(\frac{\psi_s - 2\phi_F - V_{CB}}{\phi_t}\right)$$

となる。

3端子MOS構造の場合、
2端子MOS構造の場合の
2 ϕ_F を以下に変換するとよい

$$2\phi_F \Rightarrow 2\phi_F + V_{CB}$$

2端子MOS構造の $n_{surface}$

$$n_{surface} \cong N_A e^{\frac{\psi_s - 2\phi_F}{\phi_t}}$$

3端子MOS構造(正孔密度)

深さ y 方向の正孔密度 $p(y)$ は

$$\begin{aligned} p(y) &= n_i \exp\left(\frac{E_i(y) - E_{Fp}}{kT}\right) \\ &= n_i \exp\left(\frac{\phi_F - \psi(y)}{\phi_t}\right) \\ &= p_0 \exp\left(-\frac{\psi(y)}{\phi_t}\right) \cong N_A \exp\left(-\frac{\psi(y)}{\phi_t}\right) \end{aligned}$$

$$\because \phi_F = \phi_t \ln\left(\frac{p_0}{n_i}\right) \Rightarrow n_i = p_0 \exp\left(-\frac{\phi_F}{\phi_t}\right)$$

3端子MOS構造の反転状態における関係式(1)

電圧と電荷の関係

$$V_{GB} = \psi_{ox} + \psi_s + \phi_{MS}$$

$$Q'_G + Q'_o + Q'_I + Q'_B = 0$$

$$Q'_G = C'_{ox}\psi_{ox}$$

$$Q'_B = -\sqrt{2q\epsilon_s N_A}\sqrt{\psi_s} = -\gamma C'_{ox}\sqrt{\psi_s}$$

$$Q'_I = -\sqrt{2q\epsilon_s N_A} \left(\sqrt{\psi_s + \phi_t e^{[\psi_s - (2\phi_F + V_{CB})]/\phi_t}} - \sqrt{\psi_s} \right)$$

また、 Q'_I は以下で表される。

$$Q'_I = -C'_{ox}(V_{GB} - V_{FB} - \psi_s - \gamma\sqrt{\psi_s})$$

2端子MOS構造の反転層電荷密度

$$Q'_I = -\sqrt{2q\epsilon_s N_A} \left(\sqrt{\psi_s + \phi_t e^{\frac{\psi_s - 2\phi_F}{\phi_t}}} - \sqrt{\psi_s} \right)$$

$$2\phi_F \Rightarrow 2\phi_F + V_{CB}$$



3端子MOS構造の反転状態における関係式(2)

$$V_{GB} = -\frac{1}{C'_{ox}} [Q'_o + Q'_I(\psi_s) + Q'_B(\psi_s)] + \psi_s + \phi_{MS}$$

$$= \phi_{MS} - \frac{Q'_o}{C'_{ox}} + \psi_s - \frac{Q'_I(\psi_s) + Q'_B(\psi_s)}{C'_{ox}}$$

$$= V_{FB} + \psi_s - \frac{Q'_I(\psi_s) + Q'_B(\psi_s)}{C'_{ox}} \quad \Rightarrow Q'_I \text{ と } Q'_B \text{ に関し p. 8 を参照}$$

$$V_{GB} = V_{FB} + \psi_s + \gamma \sqrt{\psi_s + \phi_t e^{[\psi_s - (2\phi_F + V_{CB})]/\phi_t}}$$

3端子MOS構造の反転状態における関係式(3)

容量と表面電位の関係

$$\frac{1}{C'_g} = \frac{1}{C'_{ox}} + \frac{1}{C'_c}, \quad \frac{1}{C'_g} = \frac{1}{C'_{ox}} + \frac{1}{C'_b + C'_i}$$

$$C'_c = \sqrt{2q\epsilon_s N_A} \frac{1 + e^{[\psi_s - (2\phi_F + V_{CB})]/\phi_t}}{2\sqrt{\psi_s + \phi_t e^{[\psi_s - (2\phi_F + V_{CB})]/\phi_t}}}$$

$$C'_b = \sqrt{2q\epsilon_s N_A} \frac{1}{2\sqrt{\psi_s + \phi_t e^{[\psi_s - (2\phi_F + V_{CB})]/\phi_t}}}$$

$$C'_i = \sqrt{2q\epsilon_s N_A} \frac{e^{[\psi_s - (2\phi_F + V_{CB})]/\phi_t}}{2\sqrt{\psi_s + \phi_t e^{[\psi_s - (2\phi_F + V_{CB})]/\phi_t}}}$$

C'_g ⇒ 単位面積当たりのゲート～基板間容量

C'_{ox} ⇒ 単位面積当たりの酸化膜容量

C'_c ⇒ 単位面積当たりの半導体側の容量

C'_b ⇒ 単位面積当たりの空乏層容量

C'_i ⇒ 単位面積当たりの反転層容量

2端子MOS構造の単位面積当たりの空乏層容量

$$C'_b = \sqrt{2q\epsilon_s N_A} \frac{1}{2\sqrt{\psi_s + \phi_t e^{(\psi_s - 2\phi_F)/\phi_t}}}$$

2端子MOS構造の単位面積当たりの反転層容量

$$C'_i = \sqrt{2q\epsilon_s N_A} \frac{e^{(\psi_s - 2\phi_F)/\phi_t}}{2\sqrt{\psi_s + \phi_t e^{(\psi_s - 2\phi_F)/\phi_t}}}$$

$$2\phi_F \Rightarrow 2\phi_F + V_{CB}$$

3端子MOS構造の反転状態における関係式(4)

弱反転領域: $\psi_s \Rightarrow \psi_{sa}$ (近似)

$$V_{GB} \approx V_{FB} + \psi_{sa} - \frac{Q'_B(\psi_{sa})}{C'_{ox}} = V_{FB} + \psi_{sa} + \gamma\sqrt{\psi_{sa}}$$

ψ_{sa} を解くと、

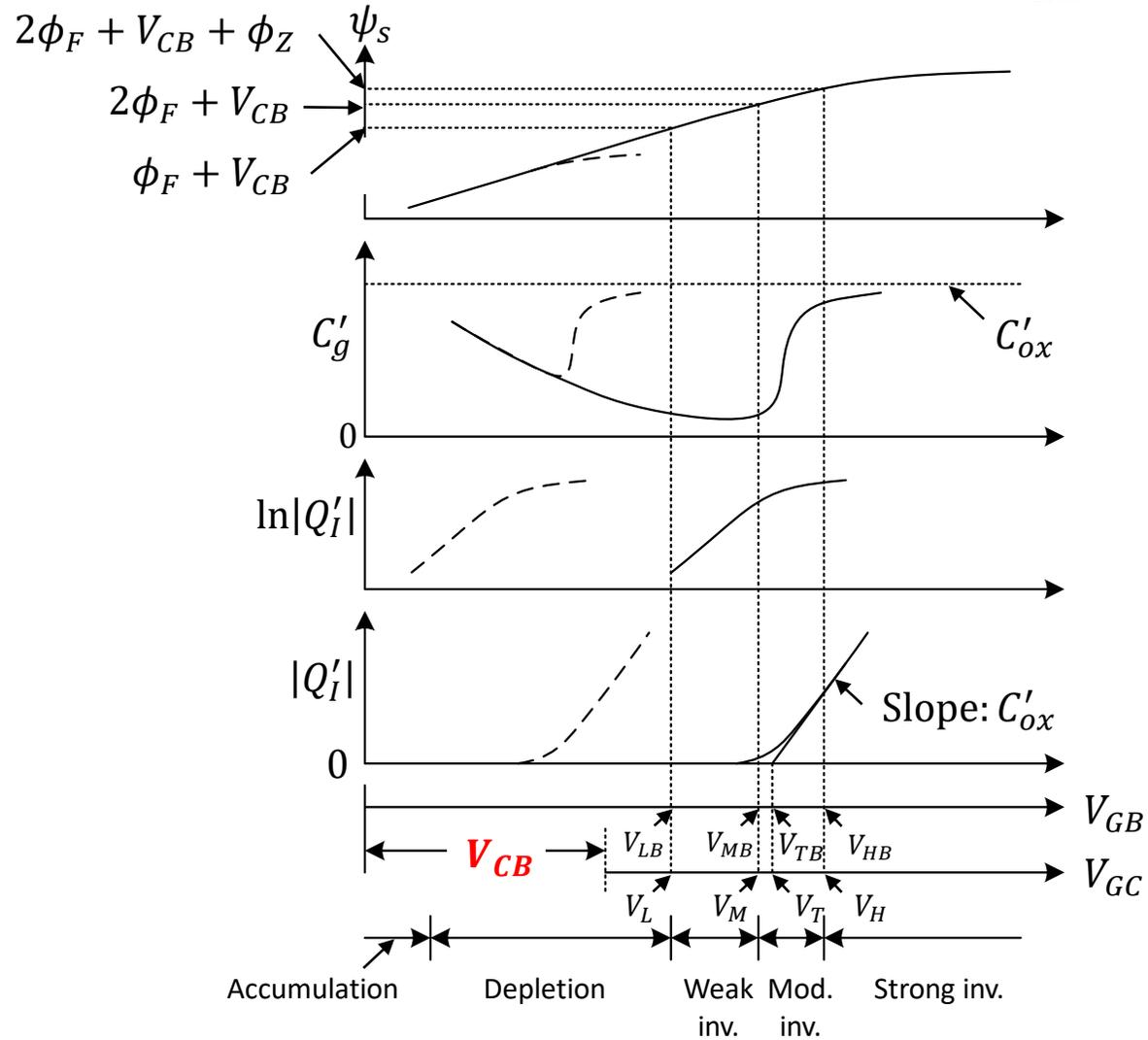
$$\psi_{sa} = \left(-\frac{\gamma}{2} + \sqrt{\frac{\gamma^2}{4} + V_{GB} - V_{FB}} \right)^2$$

表面電位 ψ_{sa} は
ゲート～基板間電圧 V_{GB} の関数になる

となる。また、 n は、以下になる。

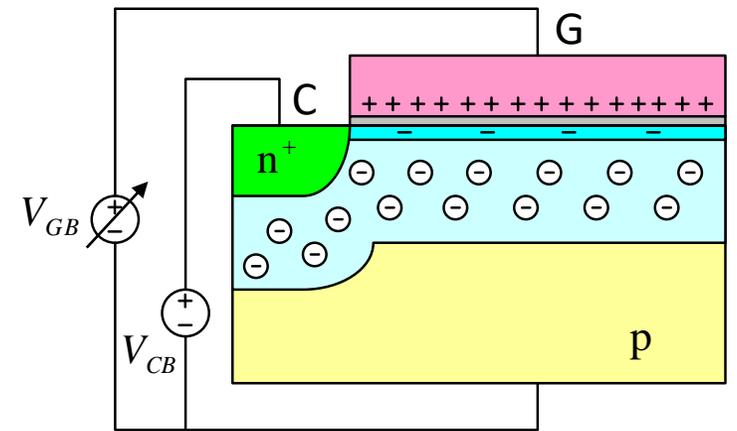
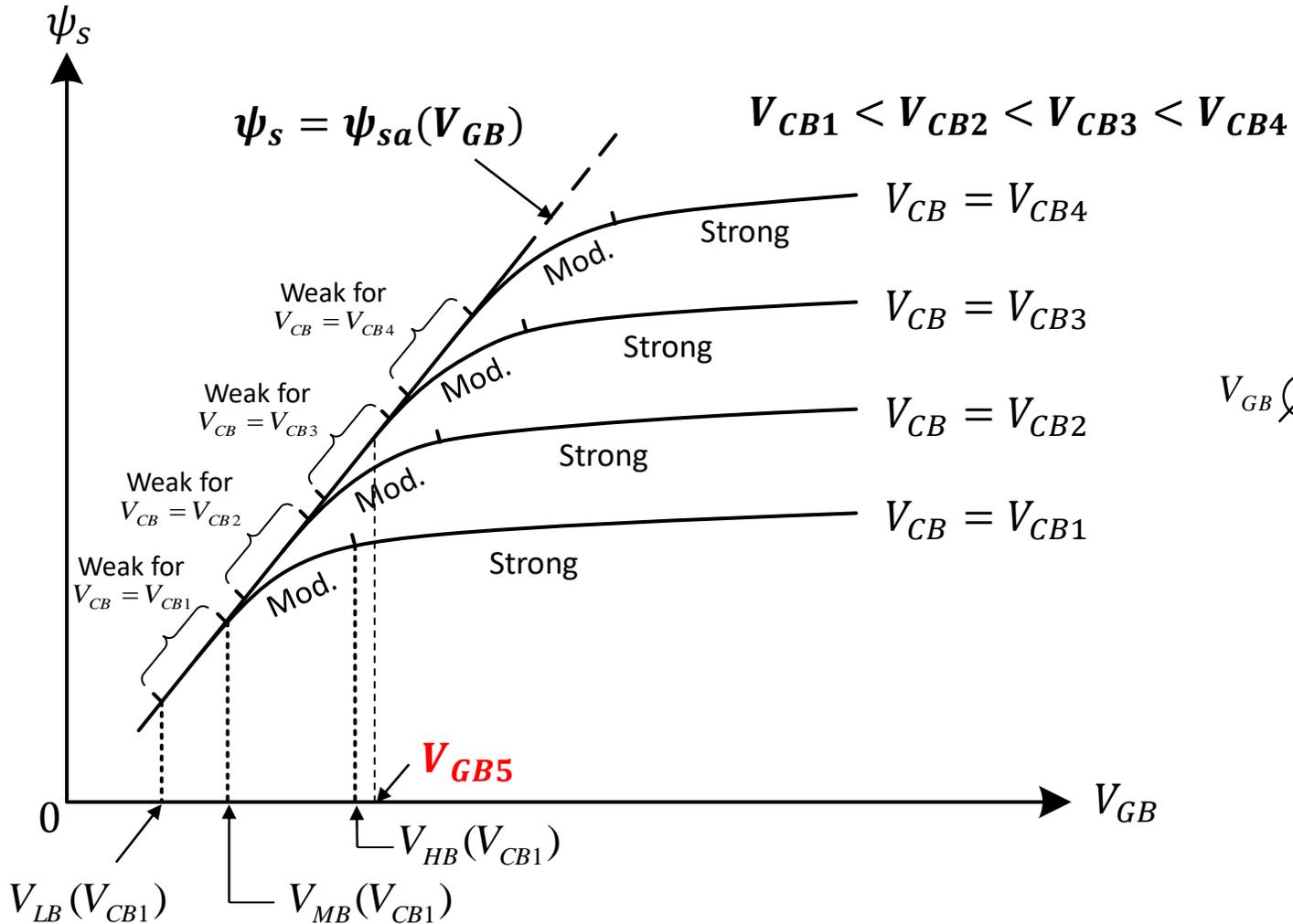
$$n \equiv \left(\frac{d\psi_{sa}}{dV_{GB}} \right)^{-1} = 1 + \frac{\gamma}{2\sqrt{\psi_{sa}(V_{GB})}}$$

表面電位、ゲート容量、反転層電荷の V_{GB} 及び V_{GC} 依存性



破線: $V_{CB} = 0$
 実線: $V_{CB} (> 0)$ 印加

表面電位とゲート基板間電圧 (V_{CB} : パラメータ)



V_{CB} (固定)、 V_{GB} を上昇
 (弱反転 \Rightarrow 強反転)

基板効果

- 強反転の状態では V_{CB} 増大 (反転層/基板 \Rightarrow N^+ (シート形状) / P接合と同じ)
 - 反転層電荷密度低下
 - 同じ反転状態を保持 \Rightarrow より大きな V_{GC} が必要 (電荷バランス)
 - しきい値電圧 V_T 増大
- 上記 V_{CB} 増大に伴う V_T 増大
 - 基板不純物ドーピング濃度増大と酸化膜厚増大 $\Rightarrow V_T$ はより増大する
- 弱反転又は空乏領域
 - V_{CB} の表面電位への影響なし

基板バイアス係数

$$\gamma = \frac{\sqrt{2q\epsilon_s N_A}}{C'_{ox}}$$

各反転領域の境界

	境界		
	空乏領域と弱反転領域	弱反転領域と中反転領域	中反転領域と強反転領域
表面電位 ψ_s	$\phi_F + V_{CB}$	$2\phi_F + V_{CB}$	$2\phi_F + V_{CB} + \phi_Z$
V_{GB} for a given V_{CB}	$V_{LB} = V_L + V_{CB}$	$V_{MB} = V_M + V_{CB}$	$V_{HB} = V_H + V_{CB}$
V_{GC} for a given V_{CB}	$V_L =$ $V_{FB} + \phi_F + \sqrt{\phi_F + V_{CB}}$	$V_M =$ $V_{FB} + 2\phi_F + \sqrt{2\phi_F + V_{CB}}$	$V_H = V_M + V_Z$
V_{CB} for a given V_{GB}	$V_U =$ $\left(-\frac{\gamma}{2} + \sqrt{\frac{\gamma^2}{4} + V_{GB} - V_{FB}}\right)^2 - \phi_F$	$V_W =$ $\left(-\frac{\gamma}{2} + \sqrt{\frac{\gamma^2}{4} + V_{GB} - V_{FB}}\right)^2 - 2\phi_F$	$V_Q =$ $\left(-\frac{\gamma}{2} + \sqrt{\frac{\gamma^2}{4} + V_{GB} - V_{FB} - V_Z}\right)^2 - 2\phi_F$

(注1) ϕ_Z : プロセス・パラメータ、温度、 V_{CB} の弱い関数、(注2) V_Z : 0.5~0.6V (室温)

各反転領域の範囲：3端子MOS構造

	弱反転	中反転	強反転
ψ_s の範囲	$\phi_F + V_{CB} \leq \psi_s < 2\phi_F + V_{CB}$	$2\phi_F + V_{CB} \leq \psi_s < 2\phi_F + V_{CB} + \phi_Z$	$2\phi_F + V_{CB} + \phi_Z \leq \psi_s$
V_{GB} for a given V_{CB}	$V_{LB} \leq V_{GB} < V_{MB}$	$V_{MB} \leq V_{GB} < V_{HB}$	$V_{HB} \leq V_{GB}$
V_{GC} for a given V_{CB}	$V_L \leq V_{GC} < V_M$	$V_M \leq V_{GC} < V_H$	$V_H \leq V_{GC}$
V_{CB} for a given V_{GB}	$V_U \geq V_{CB} > V_W$	$V_W \geq V_{CB} > V_Q$	$V_Q \geq V_{CB}$

各反転領域の特性：3端子MOS構造

	弱反転	中反転	強反転
$\frac{ Q_I' }{ Q_B' }$	$\ll 1$	Varies	$\gg 1$
$\frac{ C_I' }{ C_b' }$	$\ll 1$	Varies	$\gg 1$
$\frac{d\psi_s}{dV_{GB}}$	Approximately constant	Varies	Small
$\frac{d\psi_s}{dV_{CB}}$	Very small	Varies	Close to 1
Dependence of Q_I' on V_{GB} or V_{GC} for V_{CB} constant	Approximately exponential	—	Approximately first-degree polynomial
$\frac{d \ln Q_I' }{d\psi_s}$	$\frac{1}{\phi_t}$	Varies	$\frac{1}{2\phi_t}$

強反転領域(1)

$$V_{GB} \geq V_{HB}(V_{CB}), \quad |Q'_I| \gg |Q'_B|$$

表面電位

$$\psi_s \cong \phi_0 + V_{CB}, \quad \phi_0 \cong 2\phi_F + \Delta\phi$$

$$\Rightarrow \frac{d\psi_s}{dV_{CB}} \cong 1$$

空乏層幅

$$d_{Bm} = \sqrt{\frac{2\varepsilon_s}{qN_A}} \sqrt{\phi_0 + V_{CB}}$$

空乏層電荷

$$Q'_B = -\sqrt{2q\varepsilon_s N_A} \sqrt{\phi_0 + V_{CB}}$$

反転層電荷

$$\begin{aligned} Q'_I &= -C'_{ox}(V_{GB} - \phi_{MS} - \phi_0 - V_{CB}) - Q'_o - Q'_B \\ &= -C'_{ox}(V_{GB} - V_{TB}) \end{aligned}$$

$$V_{TB} = V_{FB} + \phi_0 + V_{CB} + \gamma\sqrt{\phi_0 + V_{CB}}$$

V_{TB} : 基板(B)に対するしきい値電圧

$$\Delta\phi \cong 6\phi_t \quad \phi_t = \frac{kT}{q} \text{ (熱電圧)}$$

強反転領域(2)

V_{TB} は

$$V_{TB} = V_T + V_{CB}$$

$$V_T = V_{FB} + \phi_0 + \gamma\sqrt{\phi_0 + V_{CB}}$$

である。また、 V_T は

$$V_T = V_{T0} + \gamma(\sqrt{\phi_0 + V_{CB}} - \sqrt{\phi_0})$$

$$V_{T0} = V_{FB} + \phi_0 + \gamma\sqrt{\phi_0}$$

である。ここで、 $\phi_0 = 2\phi_F$ の場合、

$$V_T = V_M$$

となる。また、反転層電荷は、

$$Q'_I = -C'_{ox}(V_{GB} - V_{TB})$$

$$= -C'_{ox}(V_{GC} - V_T)$$

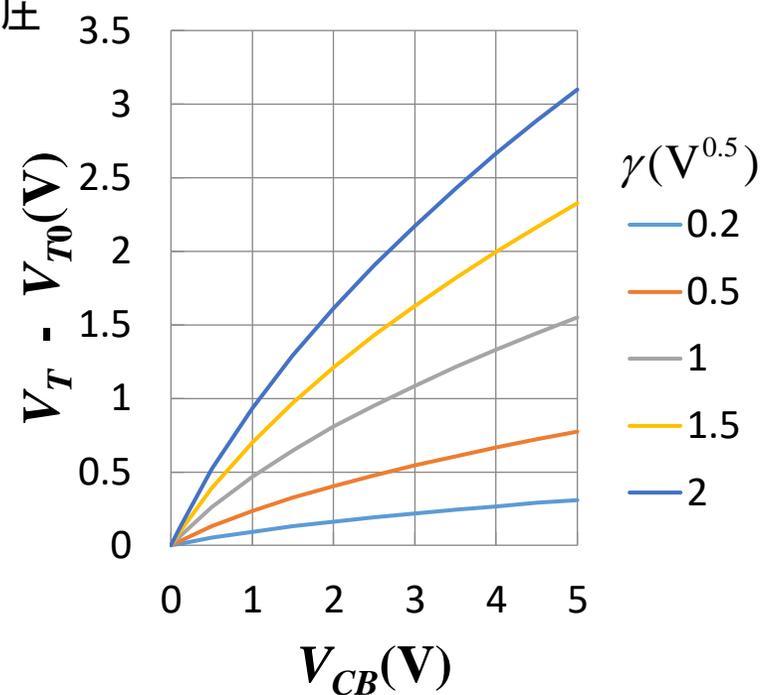
である。 V_{GB} は以下で表される。

$$V_{GB} = V_{GC} + V_{CB}$$

V_{TB} : 基板(B)に対するしきい値電圧

V_T : n^+ 領域(C)に対するしきい値電圧

V_{T0} : 基板バイアスゼロ ($V_{CB}=0$)
における n^+ 領域(C)に
対するしきい値電圧



弱反転領域(1)

$$V_{LB}(V_{CB}) \leq V_{GB} \leq V_{MB}(V_{CB}), \quad Q'_I \ll Q'_B$$

$\psi_s < 2\phi_F + V_{CB}$ だから

$$Q'_I = -\frac{\sqrt{2q\epsilon_s N_A}}{2\sqrt{\psi_{sa}(V_{GB})}} \phi_t e^{[\psi_s - (2\phi_F + V_{CB})]/\phi_t}$$

表面電位は、

$$\psi_s \cong \psi_{sa}(V_{GB}) = \left(-\frac{\gamma}{2} + \sqrt{\frac{\gamma^2}{4} + V_{GB} - V_{FB}} \right)^2$$

したがって、

$$Q'_I = -\frac{\sqrt{2q\epsilon_s N_A}}{2\sqrt{\psi_{sa}(V_{GB})}} \phi_t e^{[\psi_{sa}(V_{GB}) - 2\phi_F]/\phi_t} \cdot e^{-V_{CB}/\phi_t}$$

2端子MOS構造の弱反転における反転層電荷密度

$$Q'_I = -\frac{\sqrt{2q\epsilon_s N_A}}{2\sqrt{\psi_{sa}(V_{GB})}} \phi_t e^{[\psi_{sa}(V_{GB}) - 2\phi_F]/\phi_t}$$

$$2\phi_F \Rightarrow 2\phi_F + V_{CB}$$

弱反転領域(2)

表面電位とゲート電圧との関係は

$$\begin{aligned}\psi_{sa} - (2\phi_F + V'_{CB}) &\approx \frac{1}{n} (V_{GB} - V_{MB}) \\ &= \frac{1}{n} (V_{GC} - V_M)\end{aligned}$$

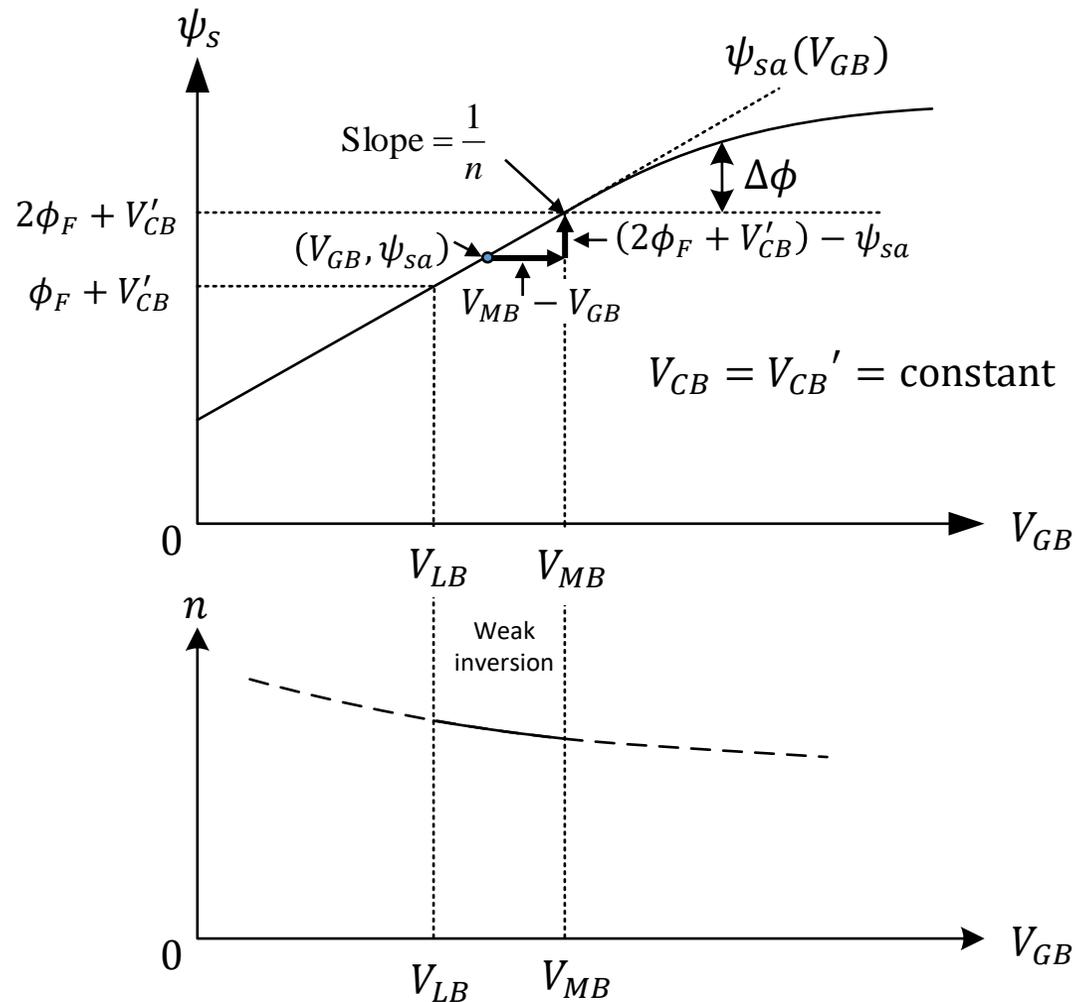
ここで、

$$\begin{aligned}n &= 1 + \frac{\gamma}{2\sqrt{\psi_{sa}(V_{GB})}} \\ &= 1 + \frac{\gamma}{2\sqrt{2\phi_F + V'_{CB}}}\end{aligned}$$

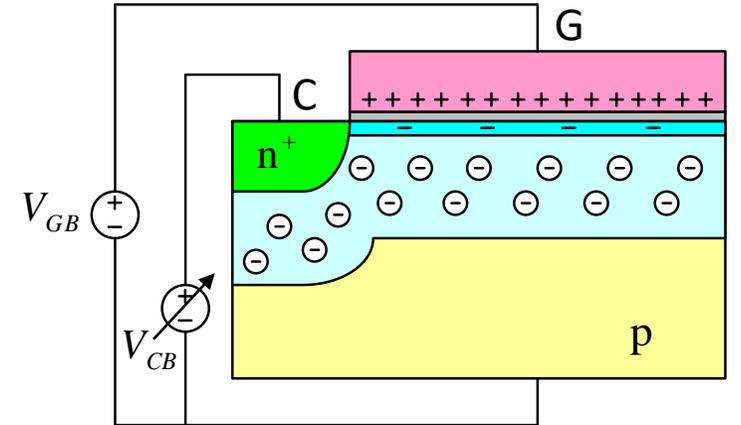
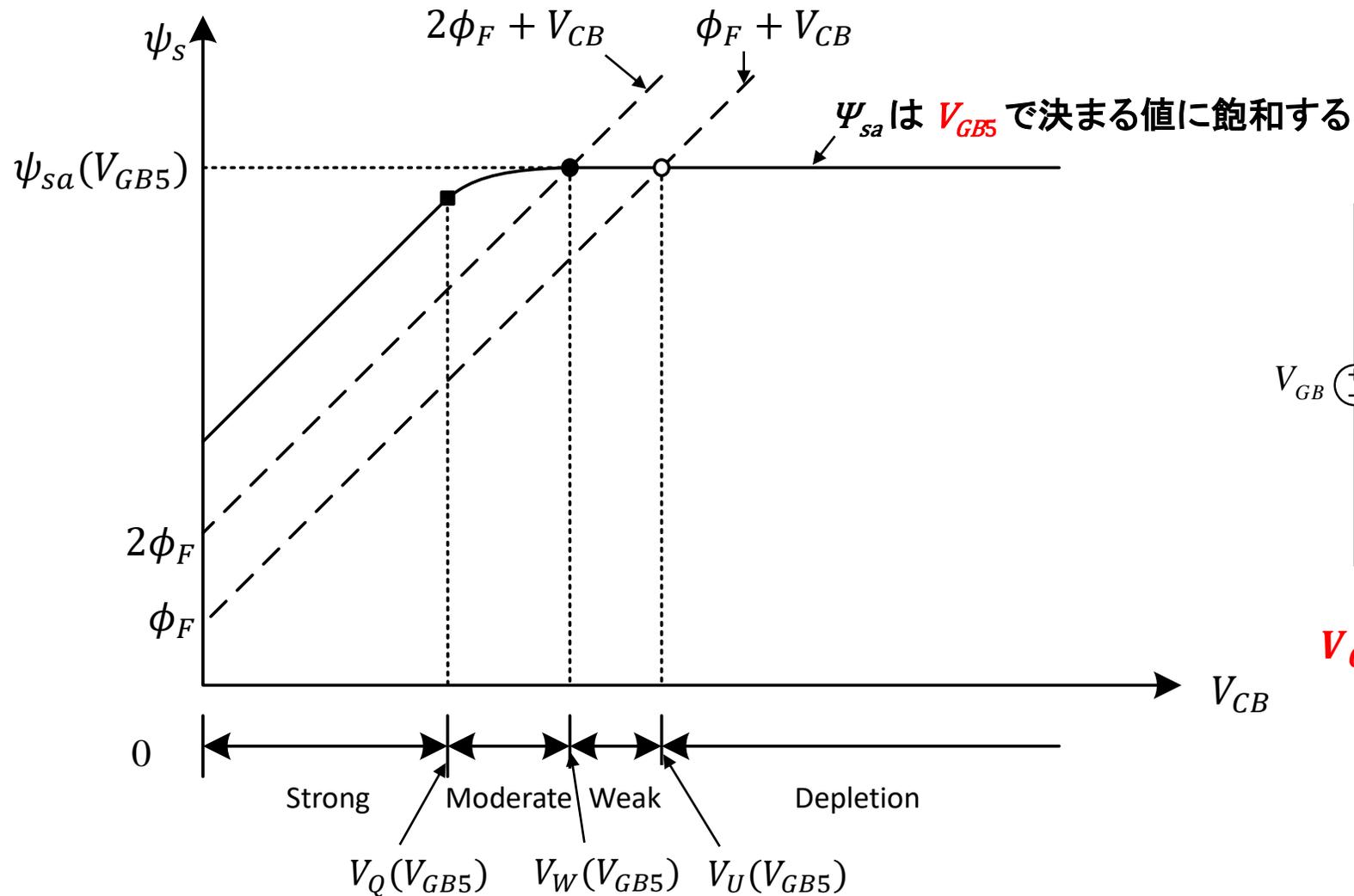
したがって、

$$Q'_I \approx Q'_M e^{(V_{GC} - V_M)/(n\phi_t)}$$

$$Q'_M = -\frac{\sqrt{2q\epsilon_s N_A}}{2\sqrt{2\phi_F + V'_{CB}}} \phi_t$$

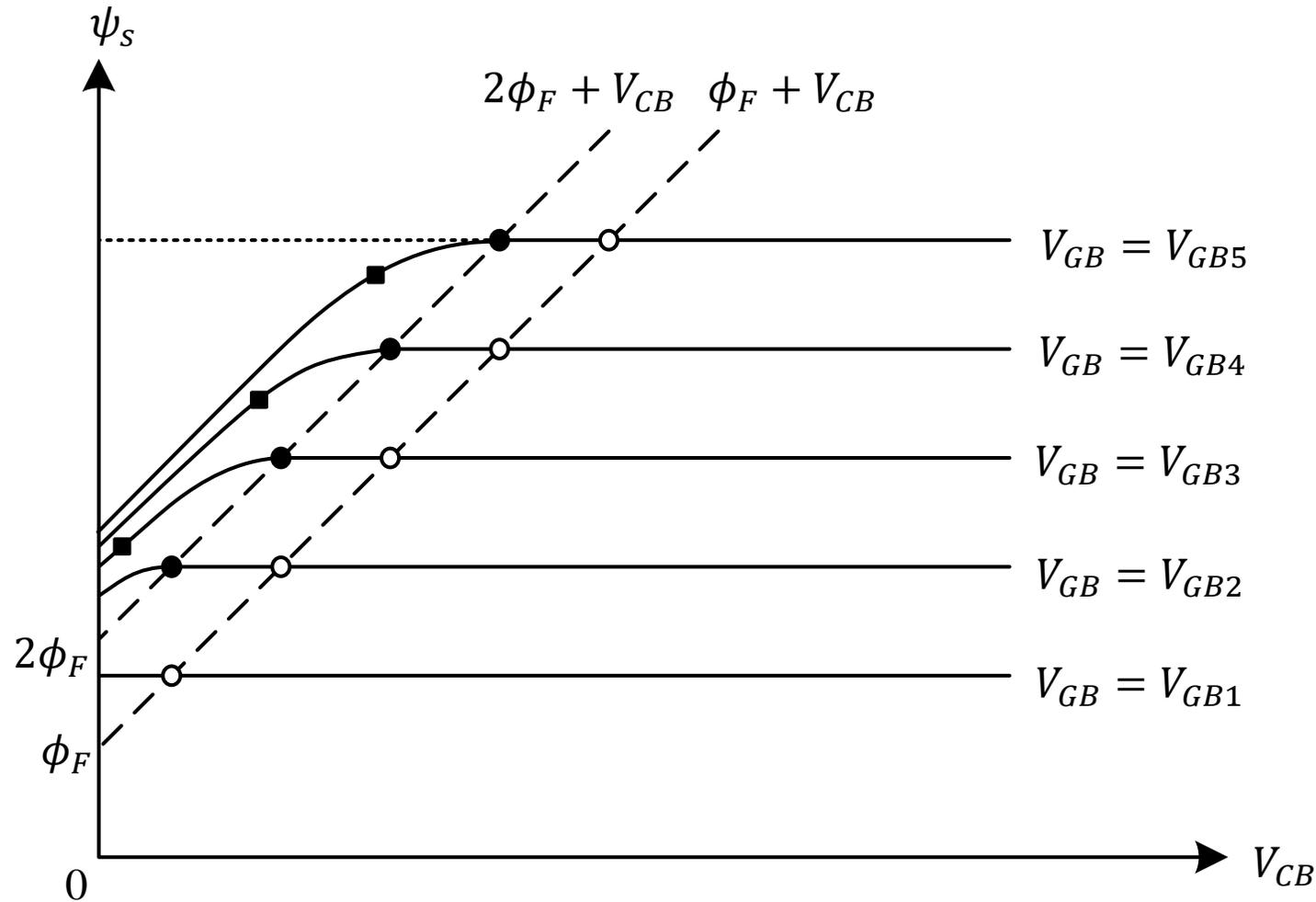


基板電圧制御(1)



$V_{GB} = V_{GB5}$ (固定)、 V_{CB} を上昇
 (強反転 \Rightarrow 弱反転)

基板電圧制御(2)



V_{GB} (固定)、 V_{CB} を上昇
(強反転 \Rightarrow 弱反転)

$$V_{GB1} < V_{GB2} < V_{GB3} < V_{GB4} < V_{GB5}$$

V_U 、 V_W 、 V_Q の導出(1)

V_W の導出

$$V_{GB} = V_{FB} + \psi_s + \gamma\sqrt{\psi_s}$$

ここで、 $\psi_s = 2\phi_F + V_W$ とおくと、

$$\begin{aligned} V_{GB} &= V_{FB} + 2\phi_F + V_W + \gamma\sqrt{2\phi_F + V_W} \\ \sqrt{2\phi_F + V_W} &= -\frac{\gamma}{2} + \sqrt{\frac{\gamma^2}{4} + V_{GB} - V_{FB}} \\ \therefore V_W &= \left(-\frac{\gamma}{2} + \sqrt{\frac{\gamma^2}{4} + V_{GB} - V_{FB}} \right)^2 - 2\phi_F \end{aligned}$$

V_U : 弱反転領域と空乏領域の境界での V_{CB}
 V_W : 中反転領域と弱反転領域の境界での V_{CB}
 V_Q : 強反転領域と中反転領域の境界での V_{CB}

V_U 、 V_W 、 V_Q の導出(2)

同様に、

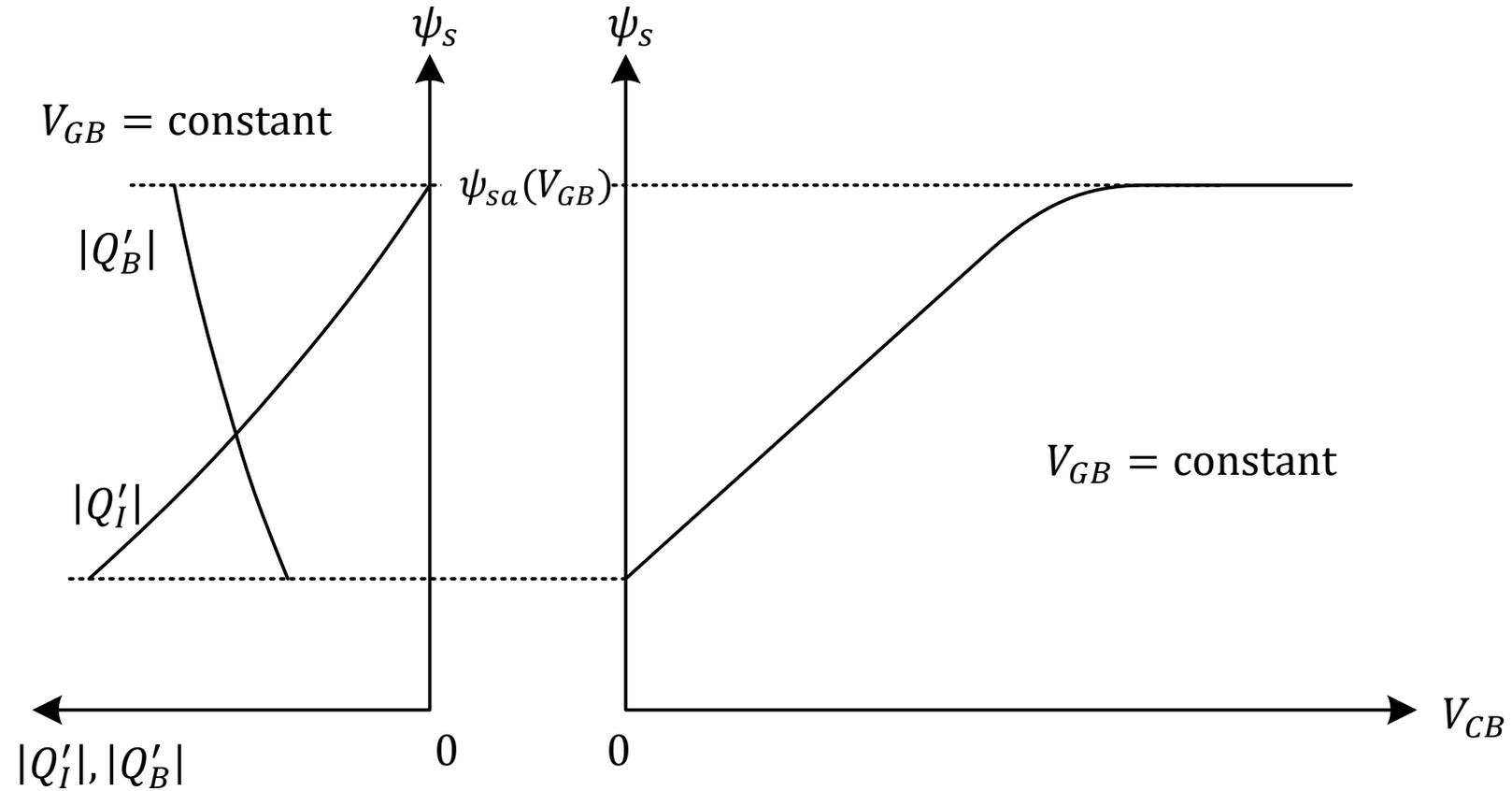
$$V_U = \left(-\frac{\gamma}{2} + \sqrt{\frac{\gamma^2}{4} + V_{GB} - V_{FB}} \right)^2 - \phi_F$$
$$V_Q = \left(-\frac{\gamma}{2} + \sqrt{\frac{\gamma^2}{4} + V_{GB} - V_{FB} - V_Z} \right)^2 - 2\phi_F$$

ここで、

$$V_Z = V_H - V_M$$

V_U の場合、 $\psi_s = \phi_F + V_U$
 V_Q の場合、 $\psi_s = 2\phi_F + V_Q + \phi_Z$
とする。ここで、弱反転と中反転の境界から
中反転と強反転の境界へ ψ_s が ϕ_Z 上昇
し、 V_{GB} は V_Z 上昇する。

基板電圧vs.表面電位、反轉層電荷、空乏層電荷



ピンチオフ電圧

ピンチオフ電圧 V_P : $Q'_I = 0$ となる V_{CB}

ピンチオフ電圧の導出

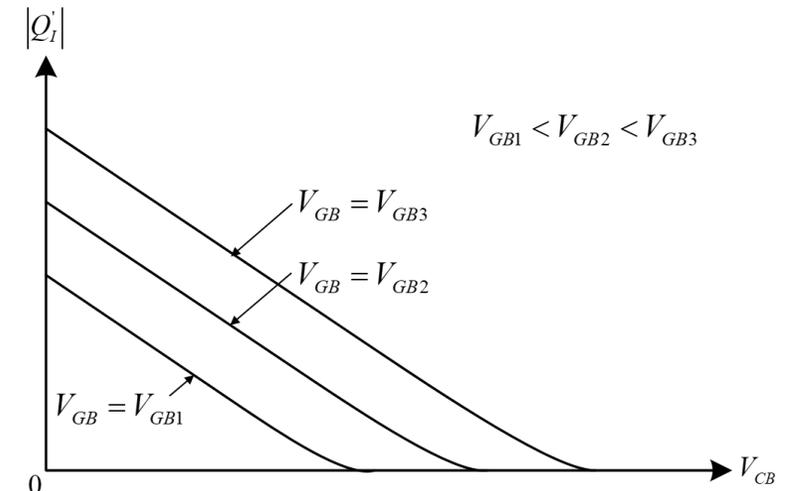
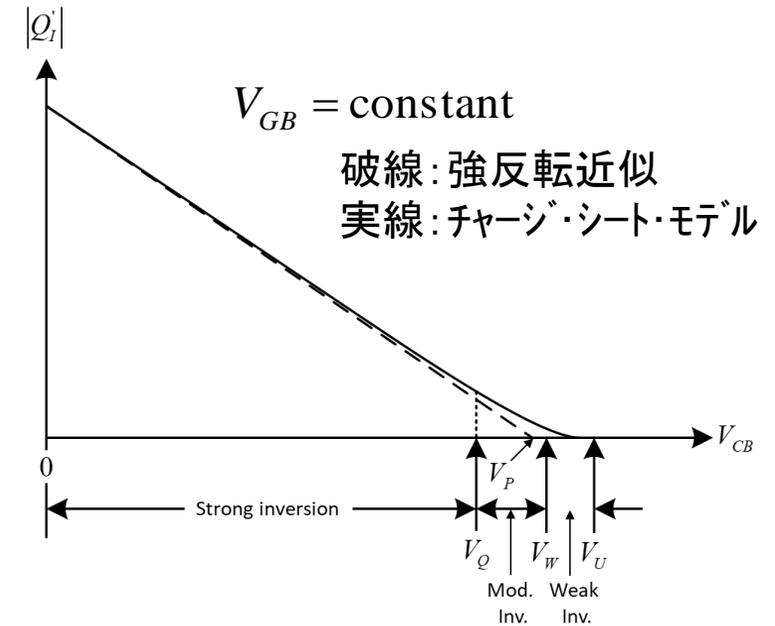
反転層電荷は、

$$\begin{aligned} Q'_I &= -C'_{ox}(V_{GB} - V_{TB}(V_{CB})) \\ &= -C'_{ox}(V_{GB} - V_{FB} - \phi_0 - V_{CB} - \gamma\sqrt{\phi_0 + V_{CB}}) \end{aligned}$$

$Q'_I = 0$ から、

$$V_{GB} - V_{FB} - \phi_0 - V_P - \gamma\sqrt{\phi_0 + V_P} = 0 \quad (\text{但し、} V_{CB} \Rightarrow V_P)$$

$$\begin{aligned} \sqrt{\phi_0 + V_P} &= -\frac{\gamma}{2} + \sqrt{\frac{\gamma^2}{4} + V_{GB} - V_{FB}} \\ \therefore V_P &= \left(-\frac{\gamma}{2} + \sqrt{\frac{\gamma^2}{4} + V_{GB} - V_{FB}} \right)^2 - \phi_0 \end{aligned}$$



ピンチオフ電圧の別表現(1)

反転層電荷は、

$Q'_I = -C'_{ox}(V_{GB} - V_{TB}(V_{CB}))$
 であるから、 V_P は、

$$V_{TB} = V_{FB} + \phi_0 + V_{CB} + \gamma\sqrt{\phi_0 + V_{CB}}$$

$V_P = V_{CB}|_{V_{TB}=V_{GB}}$
 となる。ここで、

→ V_{CB} の増大に伴い V_{TB} が上昇し、
 V_{TB} が V_{GB} になった時の V_{CB} が V_P

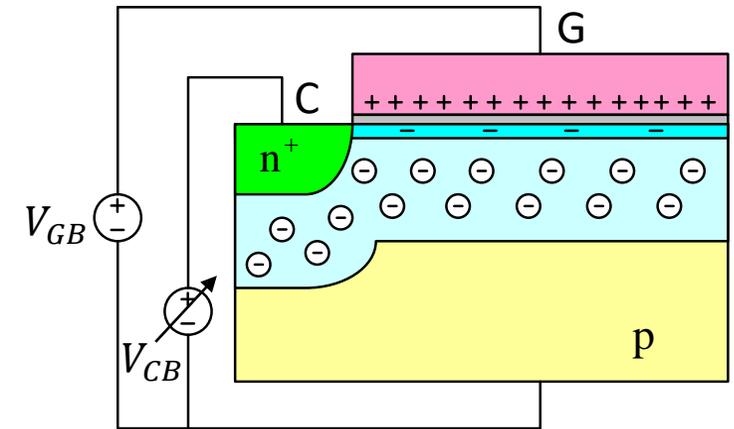
$$V_{T0} = V_{FB} + \phi_0 + \gamma\sqrt{\phi_0},$$

$$V_P = \left(-\frac{\gamma}{2} + \sqrt{\frac{\gamma^2}{4} + V_{GB} - V_{FB}} \right)^2 - \phi_0$$

上の2式から V_{FB} を消去すると、

$$V_P = V_{GB} - V_{T0} - \gamma \left[\sqrt{V_{GB} - V_{T0} + \left(\sqrt{\phi_0} + \frac{\gamma}{2} \right)^2} - \left(\sqrt{\phi_0} + \frac{\gamma}{2} \right) \right]$$

$V_{GB} = V_{T0}$ の場合、 $V_P = 0$ となる。



$$V_{TB} = V_{GB} \rightarrow V_P = V_{CB}$$

ピンチオフ電圧の別表現(2)

弱反転における以下の式と

$$\psi_{sa}(V_{GB}) = \left(-\frac{\gamma}{2} + \sqrt{\frac{\gamma^2}{4} + V_{GB} - V_{FB}} \right)^2$$

ピンチオフ電圧の以下の式

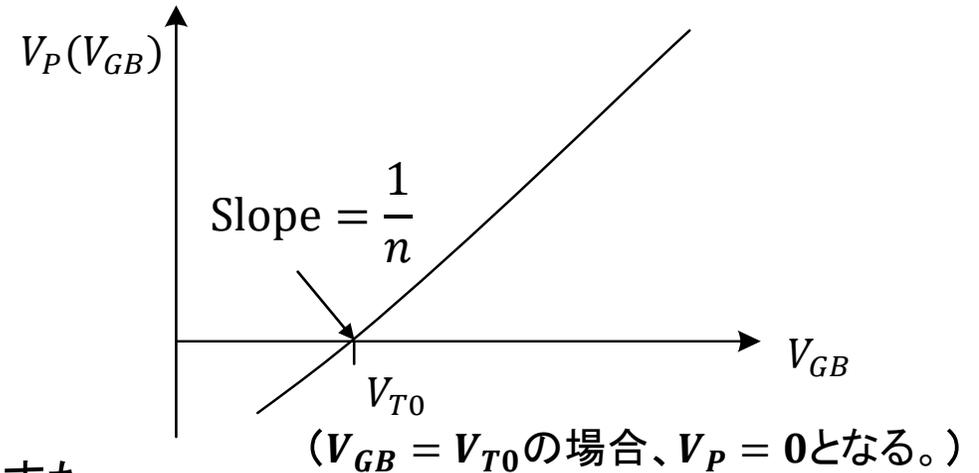
$$V_P = \left(-\frac{\gamma}{2} + \sqrt{\frac{\gamma^2}{4} + V_{GB} - V_{FB}} \right)^2 - \phi_0$$

を対比すると、

$\psi_{sa} = V_P + \phi_0$
したがって、 n は、

$$n = \left(\frac{d\psi_{sa}}{dV_{GB}} \right)^{-1} = \left(\frac{dV_P}{dV_{GB}} \right)^{-1}$$

つまり、 V_P vs. V_{GB} の傾きは、 $1/n$ になる。



また、

$$\begin{aligned} n &= 1 + \frac{\gamma}{2\sqrt{\psi_{sa}(V_{GB})}} \\ &= 1 + \frac{\gamma}{2\sqrt{\phi_0 + V_P(V_{GB})}} \end{aligned}$$

となり、 n は V_{GB} で決まる(V_{CB} でない)。
上図から、 V_P は以下になる。

$$V_P \approx \frac{V_{GB} - V_{T0}}{n}$$

ピンチオフ近傍の反転層電荷 (強反転の場合)

強反転の場合、反転層電荷が

$$Q'_I = -C'_{ox}(V_{GB} - V_{FB} - \phi_0 - V_{CB} - \gamma\sqrt{\phi_0 + V_{CB}})$$

であるから、

$$\left. \frac{dQ'_I}{dV_{CB}} \right|_{V_{CB}=V_P} = C'_{ox} \left(1 + \frac{\gamma}{2\sqrt{\phi_0 + V_{CB}}} \right) \bigg|_{V_{CB}=V_P} = C'_{ox}n$$

となる。したがって、 $V_{CB} = V_P$ 近傍で1次の展開をすると、

$$Q'_I \approx \left(\left. \frac{dQ'_I}{dV_{CB}} \right|_{V_{CB}=V_P} \right) (V_{CB} - V_P)$$

$$Q'_I \approx -nC'_{ox}(V_P - V_{CB})$$

ピンチオフ近傍の反転層電荷 (弱反転の場合)

弱反転の場合、反転層電荷が

$$Q'_I = -\frac{\sqrt{2q\epsilon_s N_A}}{2\sqrt{\psi_{sa}(V_{GB})}} \phi_t e^{[\psi_{sa}(V_{GB}) - 2\phi_F]/\phi_t} \cdot e^{-V_{CB}/\phi_t}$$

であるから、上式に $\psi_{sa} = V_P + \phi_0$ を代入すると、

$$Q'_I = -\frac{\sqrt{2q\epsilon_s N_A}}{2\sqrt{\psi_{sa}(V_{GB})}} \phi_t e^{[\phi_0 - 2\phi_F]/\phi_t} \cdot e^{(V_P - V_{CB})/\phi_t}$$